

	<h2 style="color: #E67E22;">FQA13N80-F109</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQA13N80-F109
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 12.6A TO-3P
	Datenblätter:  FQA13N80-F109.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 450 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	





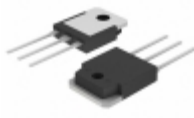



Spezifikationen

Teilenummer	FQA13N80-F109
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 12.6A TO-3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	450 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 6.3A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Andere Namen	FQA13N80_F109
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	17 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3500pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	88nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 12.6A (Tc) 300W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12.6A (Tc)

FQA13N80-F109 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQA13N80-F109-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQA13N80-F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQA13N80-F109 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQA13N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 12.6A TO-3P</p>	 <p>FQA13N50C_F109 Fairchild/ON Semiconductor FQA13N50C_F109 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FQA13N50CF_F109 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-3P</p>	 <p>FQA13N50CF_F109 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 15A TO-3P</p>
 <p>FQA140N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 140A TO-3P</p>	 <p>FQA13N80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 12.6A TO-3P</p>	 <p>FQA14N30 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 15A TO-3P</p>	 <p>FQA13N80_F109 Fairchild/ON Semiconductor FQA13N80_F109 Fairchild/ON Semiconductor</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQA13N80-F109 AMI Semiconductor / FQA13N80-F109 Datenblatt	FQA13N80-F109-Datenblätter	FQA13N80-F109 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQA13N80-F109
FQA13N80-F109 Electronic	FQA13N80-F109-Komponenten	FQA13N80-F109-Verteiler	FQA13N80-F109-Bild
FQA13N80-F109 Preis	FQA13N80-F109 Hersteller	FQA13N80-F109 Bild	FQA13N80-F109 Aktie
FQA13N80-F109 Neu	FQA13N80-F109 Original	FQA13N80-F109 garantiert	FQA13N80-F109 RFQ
			FQA13N80-F109 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited